Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №1

по теме: «Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов»

Факирзай Амджад Группа ИУ7-36б

Цель исследования:

Заполучить микросхему в программе анализа схем Micro-Cap 12 и изучить статические характеристики кремниевого полупроводникового диода с целью определения параметров модели полупроводниковых диодов. Освоить программу MathCAD для вычисления параметров модели полупроводниковых устройств на основе данных экспериментальных исследований.

Параметры диода

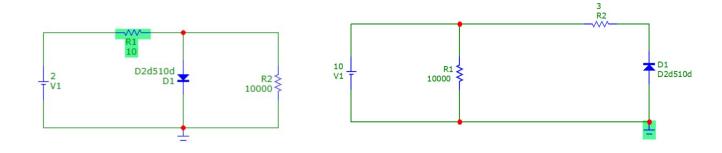
В данной лабораторной работе используется диод с номером 156, типа D2d510d. Параметры данного диода приведены на прикрепленном скриншоте.

* Variant 156

.model D2d510d D(Is=88.25p Rs=1.475 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=4p M=.3333 + Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.227u Nr=2 Bv=50.22 Ibv=517.3u Tt=2.232n)

Получение ВАХ в программе Micro-Cap

Давайте создадим схему как для прямой, так и для обратной ветви в программе Micro-Cap:



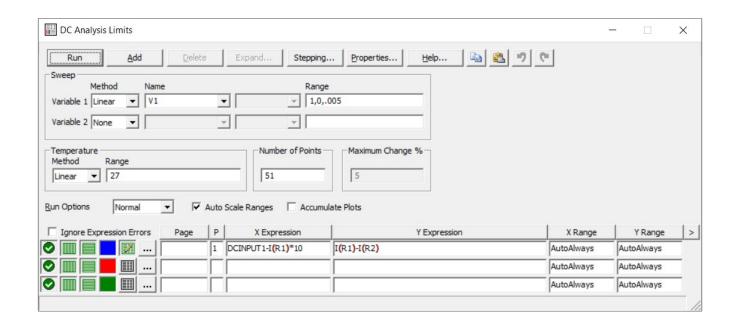
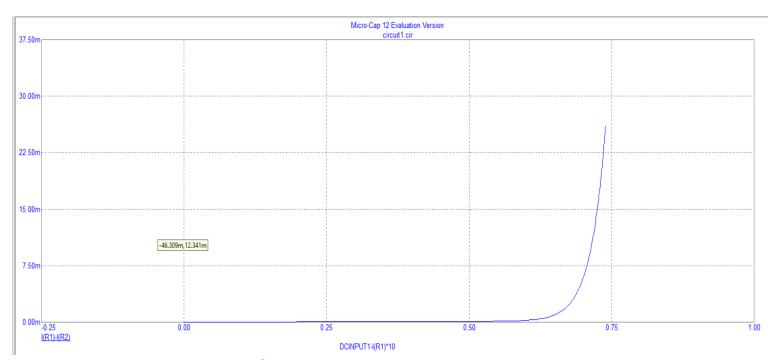


Рис. 2. Цепь для прямой ветви

Рис. 3. Цепь для обратной ветви



Продолжим, создав графики на основе данных схем с указанными настройками:

Рисунок 1 Снятие ВАХ с прямой ветви

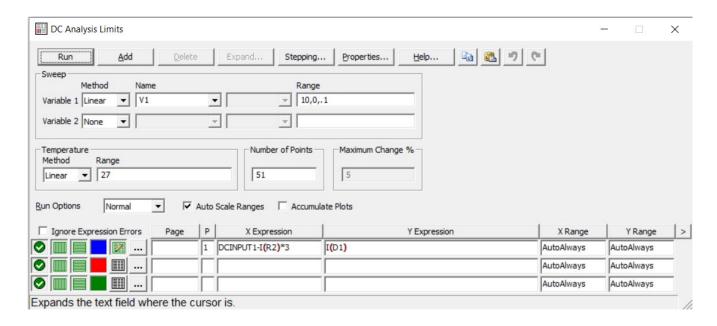


график для обратной ветви.

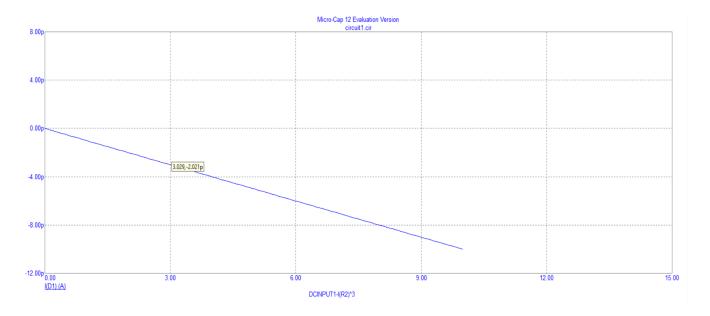
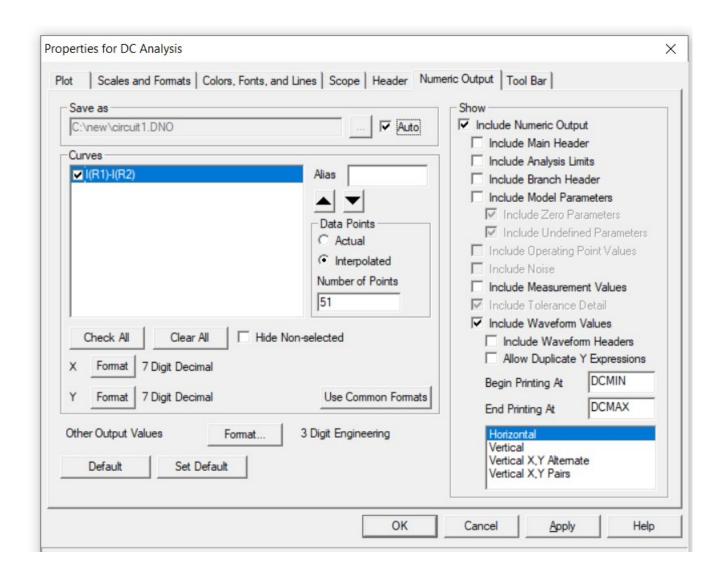


Рисунок 2 Снятие ВАХ с обратной ветви

Чтобы получить только числовые результаты вычислений в нужном формате, выполните программную настройку параметров вывода, перейдя в окно Properties -> Numeric Output.



Пункт № 2:

После получения необходимых графиков, необходимо настроить правильный вывод данных, который можно будет импортировать в программу MathCAD. В результате, содержимое нашего файла состоит только из чисел.

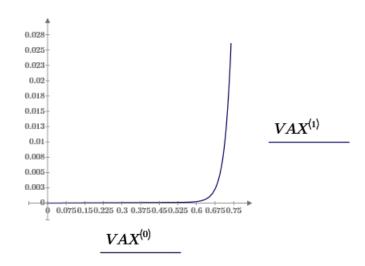
-0.0000000 0.0000000 0.0199800 0.0000040 0.0399600 0.0000080 0.0599401 0.0000120 0.0799201 0.0000160 0.0999001 0.0000200 0.1198801 0.0000240 0.1398601 0.0000280 0.1598402 0.0000320 0.1798202 0.0000360 0.1998002 0.0000400

- 0.2197802 0.0000440 0.2397602 0.0000480 0.2597403 0.0000519 0.2797203 0.0000559 0.2997003 0.0000599 0.3196803 0.0000639 0.3396603 0.0000679 0.3596403 0.0000719 0.3796201 0.0000759 0.3995999 0.0000800 0.4195793 0.0000840 0.4395580 0.0000882 0.4595353 0.0000924 0.4795092 0.0000970 0.4994762 0.0001023 0.5194279 0.0001092 0.5393468 0.0001193 0.5591955 0.0001364 0.5788958 0.0001683 0.5982897 0.0002309 0.6170833 0.0003534 0.6348028 0.0005832 0.6508607 0.0009790 0.6647901 0.0015875 0.6764732 0.0024203 0.6861261 0.0034560 0.6941122 0.0046582 0.7007907 0.0059910 0.7064564 0.0074250 0.7113342 0.0089377 0.7155917 0.0105124 0.7193537 0.0121366 0.7227137 0.0138009 0.7257428 0.0154983 0.7284959 0.0172233 0.7310160 0.0189715 0.7333372 0.0207396 0.7354870 0.0225248 0.7374877 0.0243250 0.7393577 0.0261382
- . Результаты измерений

Открываем MathCAD после получения такого файла.

 $VAX = READPRN("C:\new\circuit1.DNO")$

$$VAX = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.02 & 4 \cdot 10^{-6} \\ 0.04 & 8 \cdot 10^{-6} \\ 0.08 & 1.6 \cdot 10^{-5} \\ 0.11 & 2 \cdot 10^{-5} \\ 0.12 & 2.4 \cdot 10^{-5} \\ 0.14 & 2.8 \cdot 10^{-5} \\ 0.18 & 3.6 \cdot 10^{-5} \\ 0.22 & 4.4 \cdot 10^{-5} \\ 0.22 & 4.4 \cdot 10^{-5} \\ 0.12 & 0.22 & 4.4 \cdot 10^{-5} \\ 0.13 & 0.24 \cdot 10^{-5} \\ 0.24 & 0.24 \cdot 10^{-5} \\ 0.24 & 0.24 \cdot 10^{-5} \\ 0.25 & 0.22 & 4.4 \cdot 10^{-5} \\ 0.25 & 0.22 & 1.6 \cdot 10^{-5} \\ 0.25 & 0.22 & 1$$



Пункт № 3

С помощью функции "Трассировка" мы извлекаем координаты трех точек на графике и записываем их в переменные Ud(1,2,3) и Id(1,2,3). Затем, используя метод трех ординат, проводим приблизительные расчеты объемного

сопротивления базы (Rb), теплового потенциала (NFt) и обратного тока (Io).

$$\begin{array}{ll} Ud1 \coloneqq 0.602 & Id1 \coloneqq 0.0001763 \\ Ud2 \coloneqq 0.65 & Id2 \coloneqq 0.001 \\ Ud3 \coloneqq 0.705 & Id3 \coloneqq 0.008 \\ Rb \coloneqq \frac{\left(Ud1 - 2\ Ud2 + Ud3\right)}{Id1} = 39.705 \\ NFt \coloneqq \frac{\left[\left(3\ Ud2 - 2\ Ud1\right) - Ud3\right]}{\ln\left(2\right)} = \left[0.059\right] \\ I0 \coloneqq Id1 \cdot \exp\left(\frac{Ud3 - 2\ Ud2}{NFt}\right) = \left[7.545 \cdot 10^{-9}\right] \end{array}$$

Вычислить параметры модели полупроводникового диода с использованием метода Майнера. С помощью функции "Трассировка" скопировать координаты четырех точек с переменными Ud(1,2,3,4) и Id(1,2,3,4). Установить начальные приближения для неизвестных параметров Rb, Is0, m, Ft. Функция Minerr находит оптимальные приближенные значения неизвестных, обеспечивая минимальную погрешность. Результаты записываются в вектор Diod_Plut.

$$Ud4 := 0.719$$
 $Id4 := 0.013$ $Rb := 1$ $Is0 := 0.0000001$ $m := 2$ $Ft := 0.02$

Given
$$0.602 = Id1 \cdot Rb + \ln\left(\frac{Is0 + Id1}{Is0}\right) \cdot m \cdot Ft$$

$$0.65 = Id2 \cdot Rb + \ln\left(\frac{Is0 + Id2}{Is0}\right) \cdot m \cdot Ft$$

$$0.705 = Id3 \cdot Rb + \ln\left(\frac{Is0 + Id3}{Is0}\right) \cdot m \cdot Ft$$

$$0.719 = Id4 \cdot Rb + \ln\left(\frac{Is0 + Id4}{Is0}\right) \cdot m \cdot Ft$$

$$Diod_P := \mathbf{Minerr} \left(Is0, Rb, m, Ft\right)$$

$$Diod_P = \begin{bmatrix} 4.333 \cdot 10^{-14} \\ -0.053 \\ 1.66 \\ 0.016 \end{bmatrix}$$

Для создания графика, основанного на параметрах полупроводникового диода, вычисленных с использованием метода Minerr, мы определяем функцию Idiot, которая связывает ток диода и его напряжение. Мы строим экспериментальную VAH и теоретическую VAH на одном и том же графике. В результате графики находятся довольно близко друг к другу.

$$Rb := -0.053 \qquad Ft := 0.016 \qquad m := 1.66 \qquad Is0 := 4.333 \cdot 10^{-14}$$

$$Idiod := 0, 10^{-5} ... 0.023$$

$$Udiod (Idiod) := Idiod \cdot Rb + m \cdot Ft \cdot \ln \left(\frac{Idiod + Is0}{Is0}\right)$$

$$0.028 - 0.025 - 0.023 - 0.025 - 0.015 - 0.015 - 0.015 - 0.015 - 0.015 - 0.015 - 0.008$$

Udiod(Idiod)